

СВЕДЕНИЯ

о ведущей организации

по диссертации Фомичева А.С.

на тему «Экспериментальные исследования экзотических ядер с $Z < 20$ на ускорительном комплексе DRIBs»

по специальности 01.04.01

на соискание учёной степени доктора физико-математических наук.

Полное наименование организации в соответствии с Уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, г. Санкт-Петербург
Сокращенное наименование организации в соответствии с Уставом	ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН
Полное наименование кафедры	Отделение твердотельной электроники
Почтовый индекс, адрес организации	Россия, 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26
Веб-сайт	http://www.ioffe.ru
Телефон	+7 (812) 297-2245
Адрес электронной почты	post@mail.ioffe.ru

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)

1. Kozlovski V.V., Lebedev A.A., Levinshtein M.E., Rumyantsev S.L., Palmour J.W. *Effect of high energy electron irradiation on low frequency noise in IN 4H-SiC schottky diodes*. *Applied Physics Letters*. 2017. Т. 110. № 13. С. 133501.
2. J.C. Zamora, et al., *Nuclear-matter radius studies from ^{58}Ni (α , α) experiments at the GSI Experimental Storage Ring with the EXL facility*. *Phys. Rev. C* 96, 034617 (2017).
3. V. Eremin, et al., *Beam test of full-size prototypes of silicon detectors for TOF heavy-ions diagnostics in Super-FRS*, 2017 JINST 12 C03001.

4. V. Eremin, et al., *A comparative studies of silicon detector degradation under irradiation by heavy ions and relativistic protons*, 2018 JINST (in print).
5. V. Eremin, et al., *Picosecond timing of high-energy heavy ions with semiconductor detectors*, Nucl. Instrum. Meth. A 796 (2015) 158–164.
6. Калинина Е.В., Лебедев А.А., Богданова Е., Berenquier В., Ottaviani L., Виолина Г.Н., Скуратов В.А., *Облучение тяжёлыми ионами 4H-SiC детекторов ультрафиолетового излучения*. Физика и техника полупроводников. 2015. Т. 49. № 4. С. 550-556.
7. E. Verbitskaya, V. Eremin, I. Ilyashenko, Z. Li, *Carrier generation in irradiated Si detectors and its impact on the electric field profile, of defects in irradiated silicon detectors*, Nucl. Instrum. Meth. A 754 (2014) 63.
8. C. Nociforo, et al., *Time-of-flight measurements at the Super-FRS*, 2014 JINST 9 C01022.
9. Kozlovski V.V., Vasil'ev A.E., Emtsev V.V., Lebedev A.A. *Nonlinear effects in semiconductor-conductivity compensation by radiation defects*. Journal of Surface Investigation: X-Ray, Synchrotron and Neutron Techniques. 2014. Т. 8. № 5. С. 950-952.
10. Фадеев А.О., Лебедев А.О., Таиров Ю.М., *О росте монокристаллов карбида кремния политипа 4H на затравках с плоскостью (11-22)*. Физика и техника полупроводников (2012) т.46, вып.10, 1368-1373.